

DG417/DG418/DG419

改良型、SPST/SPDT、アナログスイッチ

概要

再設計されたマキシム社のDG417/DG418/DG419 は、スイッチ間のオン抵抗マッチング(3Ω max)及び全信号範囲でのオン抵抗の変化(4Ω max)を保証する精密CMOSモノリシックアナログスイッチです。これらのスイッチは、いずれの方向でも優れた動作を示し、低チャージインジェクション、低消費電力、及び最低2000V(3015.7法)のESD耐圧を保証します。又、新設計により、オフリーク電流が、全温度範囲にわたってこれまでよりも低く抑えられています(+85℃で5nA以下)。

DG417/DG418は、共に単極/単投(SPST)スイッチで、DG417はノーマリクローズ、DG418はノーマリオープンです。DG419は、ノーマリクローズスイッチ及びノーマリオープンスイッチを1個ずつ備えた単極/双投(SPDT)スイッチです。スイッチング時間は、 t_{ON} で最大175ns, t_{OFF} で最大145nsです。これらの製品は、+10V~+30Vの単一電源、又は ± 4.5 V~ ± 20 Vのバイポーラ電源で動作します。改良型DG417/DG418/DG419は、44Vシリコンゲートプロセスで製造されています。

アプリケーション_

サンプル/ホールド

通信システム

テスト装置

モデム

バッテリ駆動システム

ファックス

ガイダンス及び制御システム

PBX, PABX

オーディオ信号配線

軍用無線

レイルトゥレイルは日本モトローラの登録商標です。

新しい特長

- ◆ 工業標準DG417/DG418/DG419用 プラグインアップグレード
- ◆ チャネル間のオン抵抗マッチングの改善: 3 Ω max(DG419のみ)
- ◆ 全信号範囲でのオン抵抗の変化: 4Ω max
- ◆ チャージインジェクションの改善: 10pC max
- ◆ 全温度範囲にわたるオフリーク電流の改善:5nA max(+85℃)
- ◆ ESD耐圧: 2000V min(3015.7法)

従来からの特長

◆ 低温抵抗: 35Ωmax

◆ 単一電源動作:+10V~+30V

ハイポーラ電源動作: ±4.5V~±20V

♦ 低消費電力: 35µW max

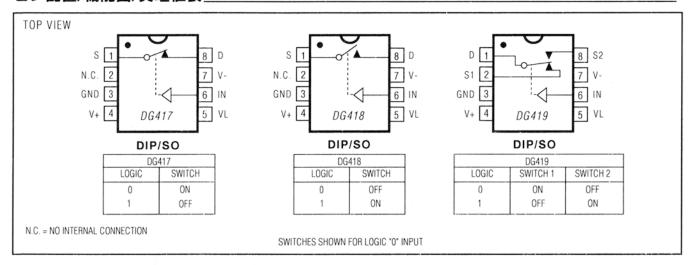
- ◆ レイルトゥレイル®の信号入力
- ◆ TTL/CMOSロジックコンパチブル

型番

PART	TEMP. RANGE	PIN-PACKAGE
DG417CJ	0°C to +70°C	8 Plastic DIP
DG417CY	0°C to +70°C	8 SO
DG417C/D	0°C to +70°C	Dice*
DG417DJ	-40°C to +85°C	8 Plastic DIP
DG417DY	-40°C to +85°C	8 SO

Ordering Information continued at end of data sheet.

ピン配置/機能図/真理値表



^{*} Contact factory for dice specifications.

改良型、SPST/SPDT、アナログスイッチ

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Voltage Referenced to V-
V+44V
GND
VL(GND - 0.3V) to (V+ + 0.3V)
Digital Inputs Vs, VD (Note 1)(V 2V) to (V+ + 2V) or 30mA
(whichever occurs first)
Continuous Current (any terminal) (Note 1)30mA
Peak Current, S or D (pulsed at 1ms, 10% duty cycle max)100mA

Continuous Power Dissipation (T _A = +70°C)	
Plastic DIP (derate 9.09mW/°C above +70)°C)727mW
SO (derate 5.88mW/°C above +70°C)	471mW
CERDIP (derate 8.00mW/°C above +70°C	:)640mW
Operating Temperature Ranges	
DG41_C	0°C to +70°C
DG41_D	40°C to +85°C
DG41_AK	55°C to +125°C
Storage Temperature Range	
Lead Temperature (soldering, 10sec)	+300°C

Note 1: Signals on S, D, or IN exceeding V+ or V- are clamped by internal diodes. Limit forward current to maximum current ratings.

Stresses beyond those listed under "Absolute Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS—Dual Supplies

(V+ = +15V, V- = -15V, VL = 5V, GND = 0V, VINL = 0.8V, VINH = 2.4V, TA = TMIN to TMAX, unless otherwise noted.)

PARAMETER	SYMBOL		MIN	TYP (Note 2)	MAX	UNITS					
SWITCH											
Analog Signal Range	V _{S_} , V _D	(Note 3)				-15		15	V		
Drain Course		V+ = 13.5V, V-	= -13.5V, T _A = +25°C C,		C, D		20	35			
Drain-Source On-Resistance	R _{DS} (ON)	$V_D = \pm 10V$		TA = +25 C	IA = +25°C		20	30	Ω		
On-Hosistanoe		Is = -10mA		TA = TMIN to T	MAX			45			
On-Resistance Match Between Channels	ΔR _{DS} (ON)	V+ = 15V, V- = VD = ±10V,	= -15V,	T _A = +25°C				3	Ω		
(Note 4)	- DS(ON)	Is = -10mA			MAX			4	7 22		
On-Resistance Flatness	RFLAT(ON)	$V_{+} = 15V, V_{-} = -15V,$ $V_{D} = \pm 5V,$ $I_{S} = -10\text{mA}$		TA = +25°C				4	Ω		
(Note 4)	nflat(ON)			TA = T _{MIN} to T	MAX			6			
Source-Off		V+ = 16.5V, V- = -16.5		T _A = +25°C		-0.25		0.25			
Leakage Current	IS(OFF)	$V_D = \pm 15.5V$, $V_S = \mp 15.5V$		TA = TMIN to	C, D	-5		5	nA		
(Note 5)				TMAX	А	-20		20			
	I _{D(OFF)}	V+ = 16.5V, V- = -16.5V, VD = ±15.5V,	DG417/ DG418	$T_A = +25^{\circ}C$		-0.25	0.1	0.25			
B 0"				TA = TMIN to	C, D	-5		5			
Drain-Off Leakage Current				TMAX	Α	-20		20	nA		
(Note 5)	ID(OFF)			$T_A = +25^{\circ}C$		-0.75	-0.1	0.75			
		VS = + 15.5V DC	$V_S = \mp 15.5V$ DG419 $T_A = T_{MIN}$ to T_{MAX} A	DG419	DG419	$T_A = T_{MIN}$ to	C, D	-10		10	
					Α	-40		40			
			DC 447/	$T_A = +25^{\circ}C$		-0.4		0.4			
Drain-On Leakage Current (Note 5)		V+ = 16.5V, V- = -16.5V, VD = ±15.5V, V0 = +15.5V	1 1	DG417/ DG418		TA = TMIN to	C, D	-10		10	
	ID(ON)		DG419		TMAX	Α	-40		40	nA	
				DG419	$T_A = +25^{\circ}C$		-0.75		0.75		
•					TA = TMIN to	C, D	-10		10		
				TMAX	Α	-40		40			

2

改良型、SPST/SPDT、アナログスイッチ

ELECTRICAL CHARACTERISTICS—Dual Supplies (continued)

 $(V+=+15V, V-=-15V, VL=5V, GND=0V, V_{INL}=0.8V, V_{INH}=2.4V, T_A=T_{MIN}$ to T_{MAX} , unless otherwise noted.)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS				TYP (Note 2)	MAX	UNITS
LOGIC INPUT				Property of the second				
Logic Input Current with Input Voltage High	linh	V _{IN} = 2.4V				0.005	0.5	μА
Logic Input Current with Input Voltage Low	I _{INL}	V _{IN} = 0.8V	V _{IN} = 0.8V				0.5	μA
DYNAMIC	•							
Turn-On Time	ton	DG417/DG418, V _D = ±10V, Figure 2		$T_A = +25^{\circ}C$ $T_A = T_{MIN} \text{ to } T_{MAX}$		100	175 250	ns
Turn-Off Time	toff	DG417/DG418, V _D = ±10V, Figure 2		$T_A = +25^{\circ}C$ $T_A = T_{MIN}$ to T_{MAX}		60	145	ns
Transition Time	ttrans	DG419, V _S = ±10V, Figure 3	DG419, $T_A = +25^{\circ}C$				175 250	ns
Break-Before-Make Interval	t _D	DG419, V _{S1} = V _{S2} = ±	DG419, V _{S1} = V _{S2} = ±10V, Figure 4, T _A = +25°C					ns
Charge Injection (Note 3)	Q	VGEN = 0V, Figure 5,	T _A = +	-25°C		3	10	рС
Off-Isolation Rejection Ratio (Note 6)	OIRR	$R_L = 500\Omega$, $C_L = 5pF$	$R_L = 500\Omega$, $C_L = 5pF$, $f = 1MHz$, Figure 6, $T_A = +25$ °C					dB
Crosstalk (Note 7)		DG419, $R_L = 50\Omega$, $C_L = 5pF$, $f = 1MHz$, Figure 7, $T_A = +25^{\circ}C$				85		dB
Drain Off-Capacitance	C _D (OFF)	$V_D = 0V$, $f = 1MHz$, F	igure 8	, T _A = +25°C		8		pF
Source Off-Capacitance	Cs (OFF)	$V_D = 0V$, $f = 1MHz$, F	igure 8	, T _A = +25°C		8		pF
Drain-Source On-Capacitance	C _D (ON)	V _S = 0V, f = 1MHz, Figure 9,	DG4	17/DG418		30		pF
on Supusitarios	Cs (ON)	$T_A = +25^{\circ}C$	DG4	19		35		
SUPPLY								
Positive Supply Current	l+	V+ = 16.5V, V- = -16.5	.5V,	T _A = +25°C	-1	-0.0001	1	μΑ
- Oshive Supply Cullett	1+	V _{IN} = 0V or 5V	$I_{IN} = 0V \text{ or } 5V$		-5		5	μΛ
Negative Supply Current	I-	V+ = 16.5V, V- = -16.5	5V,	T _A = +25°C	-1	-0.0001	1	uА
riogative copply culterit	,-	V _{IN} = 0V or 5V		$T_A = T_{MIN}$ to T_{MAX}	-5		5	μΛ
Logic Supply Current	IL	V+ = 16.5V, V- = -16.	5V,	T _A = +25°C	-1	-0.0001	1	— µА
Logic dappiy duriont	'L	V _{IN} = 0V or 5V		TA = TMIN to TMAX	-5		5	μΛ
Ground Current	IGND	V+ = 16.5V, V- = -16.5V,		T _A = +25°C	-1	-0.0001	1	μА
G. 55 6 56116111	IGND	$V_{IN} = 0V \text{ or } 5V$	$T_{N} = 0V \text{ or } 5V$ $T_{A} = T_{MIN} \text{ to } T_{MAX}$		-5		5	μΛ

Maxim Integrated 3

改良型、SPST/SPDT、アナログスイッチ

ELECTRICAL CHARACTERISTICS—Single Supply

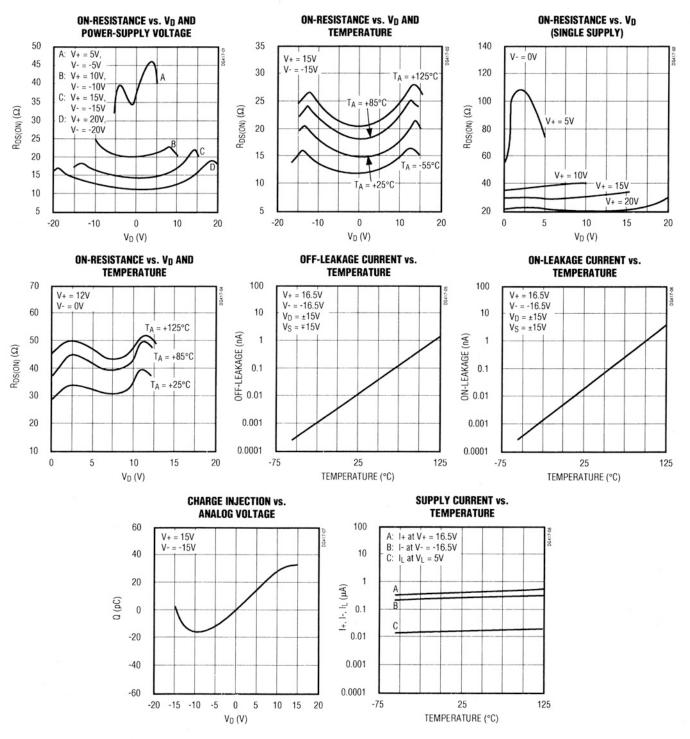
(V+ = +12V, V- = 0V, VL = 5V, GND = 0V, V_{INH} = 2.4V, V_{INL} = 0.8V, T_A = +25°C, unless otherwise noted.)

PARAMETER SYMBOL		CONDITIONS		TYP (Note 2)	MAX	UNITS
SWITCH						
Analog Signal Range	VANALOG	(Note 3)	0		12	V
Drain-Source On-Resistance	R _{DS} (ON)	$I_S = -10 \text{mA}, V_D = 3.8 \text{V}, V_{+} = 10.8 \text{V}$		40	100	Ω
DYNAMIC						
Turn-On Time	ton	DG417/DG418, V _D = 8V, Figure 2		110		ns
Turn-Off Time	toff	DG417/DG418, V _D = 8V, Figure 2		40		ns
Break-Before-Make Interval	t _D	DG419, $R_L = 1000\Omega$, $C_L = 35pF$, Figure 4		60		ns
Charge Injection (Note 3)	Q	C _L = 10nF, V _{GEN} = 0V, R _{GEN} = 0V, Figure 5	ure 5 2 10		рС	
SUPPLY						
Positive Supply Current	I+	All channels on or off, V+ = 13.2V, $V_L = 5.25V$, $V_{IN} = 0V$ or $5V$		-0.0001		μA
Negative Supply Current	I-	All channels on or off, $V+=13.2V$, $V_L=5.25V$, $V_{IN}=0V$ or $5V$	-0.0001		μА	
Logic Supply Current	ΙL	All channels on or off, $V_L = 5.25V$, $V_{\text{IN}} = 0V$ or $5V$	-0.0001		μА	
Ground Current	IGND	IGND All channels on or off, $V_L = 5.25V$, $V_{IN} = 0V$ or $5V$ -0.0001			μA	

- **Note 2:** Typical values are for **design aid only**, are not guaranteed, and are not subject to production testing. The algebraic convention where the most negative value is a minimum and the most positive value a maximum is used in this data sheet.
- Note 3: Guaranteed by design.
- **Note 4:** On-resistance match between channels and flatness is guaranteed only with bipolar-supply operation. Flatness is defined as the difference between the maximum and the minimum value of on-resistance as measured at the extremes of the specified analog range.
- Note 5: Leakage parameters I_{S(OFF)}, I_{D(OFF)}, and I_{D(ON)} are 100% tested at the maximum rated hot temperature and guaranteed by correlation at +25°C.
- Note 6: Off-Isolation Rejection Ratio = 20log (V_D/V_S), V_D = output, V_S = input to off switch.
- Note 7: Between any two switches.

標準動作特性

 $(T_A = +25^{\circ}C, unless otherwise noted.)$



端子説明

端子		47.14	## AK		
DG417	DG418	DG419	名称	機能	
1	_	_	S	アナログスイッチのソース端子(ノーマリクローズ)	
_	1	_	S	アナログスイッチのソース端子(ノーマリオープン)	
_	_	2	S1	アナログスイッチのソース端子 1 (ノーマリクローズ)	
2	2	_	N.C.	内部接続されていません	
3	3	3	GND	ロジックグランド	
4	4	4	V+	アナログ信号用正電源入力	
5	5	5	VL	ロジック電源入力	
6	6	6	IN	ロジック入力	
7	7	7	V-	アナログ信号用負電源入力	
8	8	1	D	アナログスイッチのドレイン端子	
		8	S2	アナログスイッチのソース端子2(ノーマリオープン)	

アプリケーション情報

±15V以外の電源電圧動作

 ± 15 V以外の電源を使用する場合は、アナログ信号の電圧範囲が狭くなります。DG417/DG418/DG419スイッチは、 ± 4.5 V~ ± 20 Vのバイポーラ電源、又は ± 10 V~ ± 30 Vの単一電源で動作し、単一電源動作時はV- ± 5 Vなどのアンバランスな電源でも動作します。TTLコンパチブルにするためには、VLを ± 5 Vに接続し、また、CMOSロジックレベル入力ではVLを ± 5 Vに接続します。「標準動作特性」の項に、 ± 20 V、 ± 15 V、 ± 10 V、及び ± 5 V電源でのオン抵抗(typ)のグラフが示されています。(± 5 V動作でのスイッチング時間は2倍以上増加します。)

過電圧保護

全CMOS製品に対して、正しい電源シーケンスを行うことが推奨されます。素子に定格以上の電圧が印加された場合永久的なダメージを受けるため、絶対最大定格を越えないようにすることが重要です。常にV+最初で、次にVL、V-、そしてロジック入力を接続します。電源シーケンスの順番が守れない場合、過電圧保護用に電源端子に直列に2個の小信号ダイオードを接続してください(図1)。ダイオードを加えることによって、アナログ信号範囲が(V+-1V)~(V-+1V)の範囲に低減しますが、低スイッチ抵抗、低漏れ電流特性には影響はありません。素子の動作は変わらないため、V+とV-の電圧差は+44Vを越えないようにしてください。

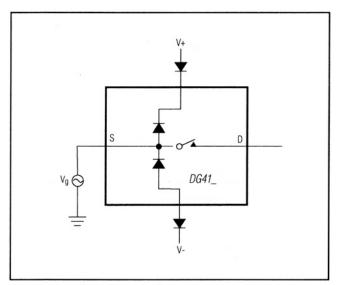


図1. 外部ブロッキングダイオードを使用した 過電圧保護

7

テスト回路/タイミングダイアグラム

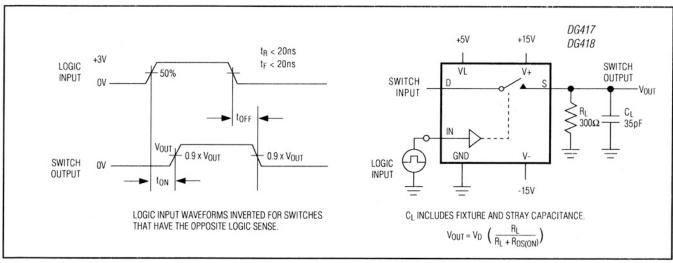


図2. DG417/DG418のスイッチング時間

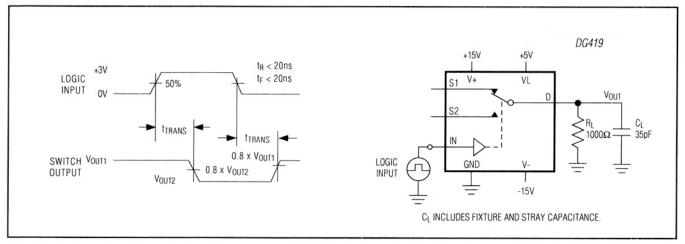


図3. DG419の遷移時間

Maxim Integrated

テスト回路/タイミングダイアグラム(続き)

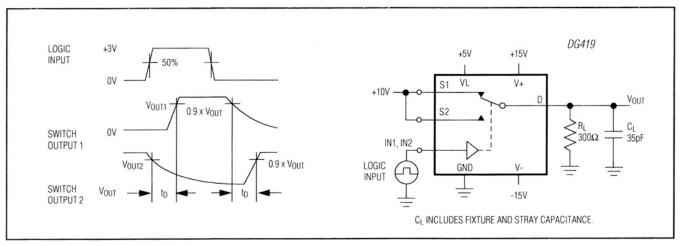


図4. DG419のブレークビフォーメーク

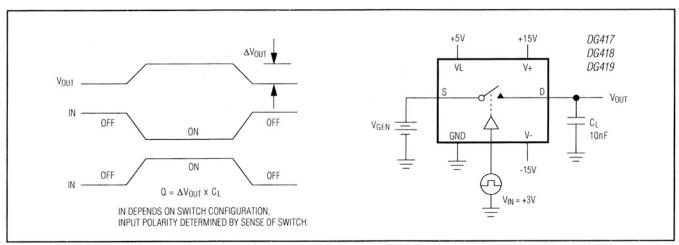


図5. チャージインジェクション

テスト回路/タイミングダイアグラム(続き)_____

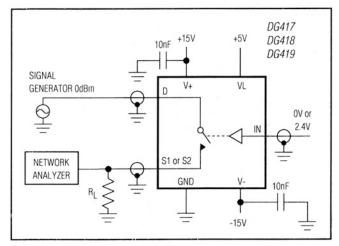


図6. オフアイソレーション

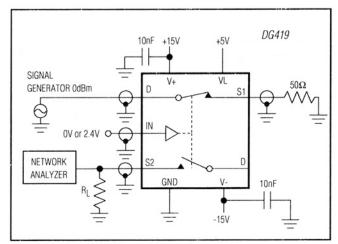


図7. DG419のクロストーク

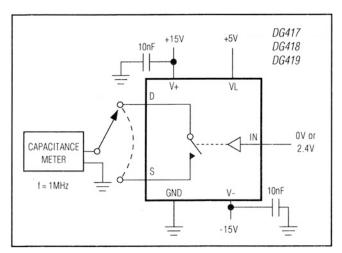


図8. ドレインソースオフ容量

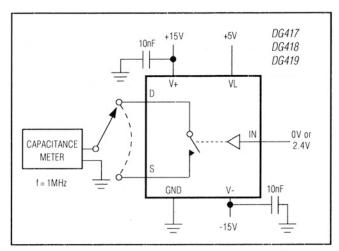


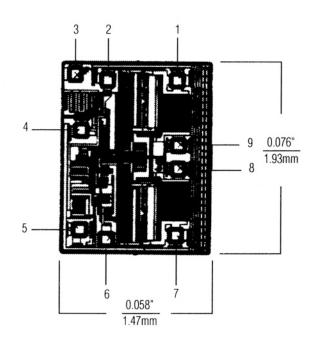
図9. ドレインソースオン容量

型番(続き) _____

PART	TEMP. RANGE	PIN-PACKAGE
DG417DK	-40°C to +85°C	8 CERDIP
DG417AK	-55°C to +125°C	8 CERDIP**
DG418CJ	0°C to +70°C	8 Plastic DIP
DG418CY	0°C to +70°C	8 SO
DG418C/D	0°C to +70°C	Dice*
DG418DJ	-40°C to +85°C	8 Plastic DIP
DG418DY	-40°C to +85°C	8 SO
DG418DK	-40°C to +85°C	8 CERDIP
DG418AK	-55°C to +125°C	8 CERDIP**
DG419CJ	0°C to +70°C	8 Plastic DIP
DG419CY	0°C to +70°C	8 SO
DG419C/D	0°C to +70°C	Dice*
DG419DJ	-40°C to +85°C	8 Plastic DIP
DG419DY	-40°C to +85°C	8 SO
DG419DK	-40°C to +85°C	8 CERDIP
DG419AK	-55°C to +125°C	8 CERDIP**

^{*} Contact factory for dice specifications.

チップ構造図



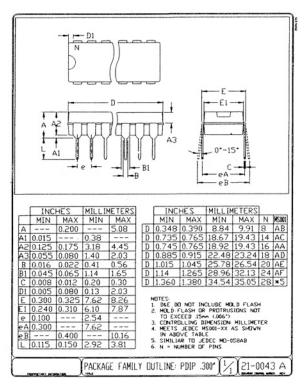
TRANSISTOR COUNT: 32 SUBSTRATE CONNECTED TO V+

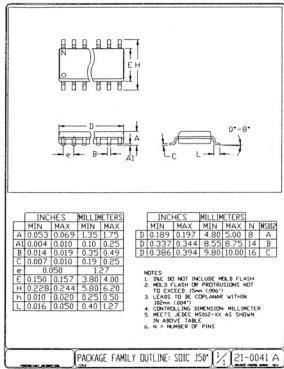
DIE PAD	DG417	DG418	DG419
1	D	N.C.	S
2	GND	GND	GND
3	V+	V+	V+
4	VL	VL	VL
5	· IN	IN	IN
6	V-	V-	V-
7	N.C.	S	S
8	N.C.	D	D
9	S	N.C.	D

^{**}Contact factory for availability and processing to MIL-STD-883B.

パッケージ

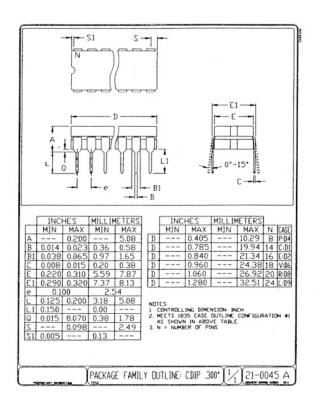
(このデータシートに掲載されているパッケージ仕様は、最新版が反映されているとは限りません。最新のパッケージ情報は、http://japan.maxim-ic.com/packagesをご参照下さい。)





パッケージ(続き)

(このデータシートに掲載されているパッケージ仕様は、最新版が反映されているとは限りません。最新のパッケージ情報は、http://japan.maxim-ic.com/packagesをご参照下さい。)



SCAN DOCUMENT

販売代理店

マキシム・ジャパン株式会社

〒169-0051東京都新宿区西早稲田3-30-16 (ホリゾン1ビル) TEL. (03)3232-6141 FAX. (03)3232-6149

マキシム社では全体がマキシム社製品で実現されている回路以外の回路の使用については責任を持ちません。回路特許ライセンスは明言されていません。マキシム社は随時予告なしに回路及び仕様を変更する権利を保留します。

12 ______Maxim Integrated Products, 120 San Gabriel Drive, Sunnyvale, CA 94086 (408) 737-7600